

湖北台基半导体股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

（一）影响分析的假设条件

以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对2019年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

相关假设如下：

1、假设本次非公开发行于2019年11月底完成（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；

2、公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有发生重大变化；

3、假设本次非公开发行最终发行数量为发行数量的上限 42,624,000 股（最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会核准情况及发行情况与保荐机构协商确定）；

4、根据公司 2018 年年度报告，公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 8,577.17 万元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为 5,873.88 万元。同时假设公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润分别较 2018 年度持平、增长 10%、增长 20%三种情况（前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策）；

5、截至本公告披露日，公司总股本为 213,120,000 股。在预测公司总股本时，以当前总股本为基础，未考虑除募集资金、净利润之外其他因素的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

6、假设公司本次非公开发行募集资金总额不超过 70,000 万元，按照上限计算且暂不考虑发行费用等的影响；

7、不考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

8、每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算。

（二）本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，上市公司测算了本次发行对公司每股收益指标的影响，如下所示：

项目	2018 年度 /2018.12.31	2019 年度/2019.12.31	
		发行前	发行后
总股本（股）	213,120,000	213,120,000	255,744,000
本次拟募集资金总额（万元）			70,000.00
预计本次发行完成的年度及月份			2019 年 11 月

项目	2018 年度 /2018.12.31	2019 年度/2019.12.31	
		发行前	发行后
假设 1：2019 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润较 2018 年持平			
归属于公司普通股股东的净利润（万元） （扣非前）	8,577.17	8,577.17	8,577.17
归属于公司普通股股东的净利润（万元） （扣非后）	5,873.88	5,873.88	5,873.88
基本每股收益（元/股） （扣非前）	0.4025	0.4025	0.3959
稀释每股收益（元/股） （扣非前）	0.4025	0.4025	0.3959
基本每股收益（元/股） （扣非后）	0.2756	0.2756	0.2711
稀释每股收益（元/股） （扣非后）	0.2756	0.2756	0.2711
假设 2：2019 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润较 2018 年增长 10%			
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非前）	8,577.17	9,434.89	9,434.89
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非后）	5,873.88	6,461.27	6,461.27
基本每股收益（元/股） （扣非前）	0.4025	0.4427	0.4354
稀释每股收益（元/股） （扣非前）	0.4025	0.4427	0.4354
基本每股收益（元/股） （扣非后）	0.2756	0.3032	0.2982
稀释每股收益（元/股） （扣非后）	0.2756	0.3032	0.2982
假设 3：2019 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润较 2018 年增长 20%			
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非前）	8,577.17	10,292.60	10,292.60

项目	2018 年度 /2018.12.31	2019 年度/2019.12.31	
		发行前	发行后
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非后）	5,873.88	7,048.66	7,048.66
基本每股收益（元/股）（扣非前）	0.4025	0.4829	0.4750
稀释每股收益（元/股）（扣非前）	0.4025	0.4829	0.4750
基本每股收益（元/股）（扣非后）	0.2756	0.3307	0.3253
稀释每股收益（元/股）（扣非后）	0.2756	0.3307	0.3253

注：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算：

（1）基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

由上述测算结果可得，本次非公开发行募集资金到位后，上市公司的总股本将有明显的增长。本次非公开发行募集资金拟用于 IGBT 模块封测线建设、高功率半导体脉冲功率开关生产线建设、晶圆线改扩建、新型高功率半导体研发中心和营销中心建设。此次募投项目与公司主营业务有直接相关关系，将为公司未来带来可持续收益。此次非公开发行完成后，公司总股本将大幅增加，而由于募投

项目建设周期较长，需一定时间周期方能产生可观效益，在项目进入正常盈利周期之前，公司的利润实现和股东回报主要仍来自于现有业务，故此次非公开发行在短期内将摊薄公司的即期回报。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2019 年度归属于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

此外，若公司本次非公开发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益将出现一定幅度的下降。

公司特别提醒投资者理性投资，注意本次非公开发行可能存在摊薄公司即期回报的风险。

三、本次发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析

本次非公开发行股票募集资金投资项目有利于公司完善产业布局及资源整合，符合公司业务发展战略，具有实施的必要性。投资项目符合国家产业政策，有利于提高公司核心竞争力，提升公司整体盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

（一）本次发行的必要性及合理性

1、项目建设符合国家产业政策导向

半导体产业作为信息产业的核心和基础，始终得到国家的高度重视和大力支持。在《产业结构调整指导目录（2011 年）》中，新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件等）被列为国家重点鼓励发展的产业。2014 年 6 月，国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出设立国家集成电路产业基金，旨在全力推进我国半导体领域的技术研发和产业发展。2015 年 5 月国务院颁布的《中国制造 2025》中，新一代信息技术产业被视为国家的

战略重点，而半导体作为新一代信息技术产业的核心发展方向，是中国迈入制造强国行列的关键。2016 年，国务院颁布的《“十三五”国家科技创新规划》中提出，要重点加强第三代半导体芯片等技术和器件的研发。《2018 年国务院政府工作报告》中，明确提出推动集成电路产业发展，加快制造强国建设，创建“中国制造 2025”示范区。

半导体产业技术含量高，研发投入大，外资厂商布局较早，在各细分行业基本处于领导地位。我国半导体产业发展起步较晚，技术积累不足，目前依然主要依赖进口，国产化率较低。2018 年，由于中美贸易摩擦，美国政府一度禁止中兴通讯向美国企业购买元器件，直接导致中兴通讯业务大范围停摆。中国半导体产业和实现自主可控的目标还有差距，国产替代是大势所趋，符合当下的国家产业政策导向。

本次非公开发行，公司将积极探索新型高功率半导体领域。通过加大新型高功率半导体研发投入，进一步在技术导入、产品研发、试验检测、应用研究等各个方面和业界机构深入开展合作，提升公司创新水平和效率，加快科研成果转化，为公司的可持续发展和半导体产业的国产替代提供更有力的技术支撑。

2、公司在战略发展和产业升级过程中需要资金支持

公司是国内大功率半导体器件领域中为数不多的掌握相关设计、制造核心技术并形成规模化生产的高新技术企业，公司具备较为完整的大功率半导体器件前道（扩散）技术、中道（芯片制程）技术及后道（封装测试）技术，拥有多项核心知识产权。

公司长期坚持自主科学创新，已经积累了具有自有知识产权的半导体产品设计和制造技术。公司作为大功率半导体器件的高新技术企业，始终将半导体技术的持续研发与创新视为公司的核心竞争力，重视科研方面的资源投入，并先后承担了国家发改委、科技部、商务部的多项重点科研项目。

功率半导体产业作为典型的高新技术产业，在发展过程中需要持续的研发投入，对资本的要求较高。公司通过本次非公开发行筹集长期发展所需的权益资金，将有效提高自身的资本规模，保障公司在产业升级方面的投入。

本次非公开发行，公司将重点开发新型IGBT模块等智能化功率器件，继续

保持在大功率半导体脉冲开关领域的技术和产品优势。此外，公司将持续研发以 SiC（碳化硅）和 GaN（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术，通过技术创新，实现产业升级，进一步提升公司在功率半导体领域中的竞争实力。

（二）本次募投项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募投项目与公司现有业务的关系

（1）月产 4 万只 IGBT 模块（兼容 MOSFET 等）封测线，兼容月产 1.5 万只 SiC 等宽禁带半导体功率器件封测项目

IGBT 模块是公司重点发展的主营业务之一，公司通过引进吸收和自主研发，已经完全掌握工业级 IGBT 模块的封测技术。目前，公司 IGBT 模块的关键技术和产品指标处于行业先进水平，且具有完全自主的知识产权。公司现已建成大功率 IGBT 模块封测线，产品电流规格在 50A 至 200A 之间，电压规格在 600V 至 1700V 之间，封装能力可以达到 5 万块/月。公司 IGBT 模块产销量不断扩大，产品广泛应用于电子机械等工业领域，如电焊机、UPS、变频器等。

本次募投项目中，公司计划拓展高功率密度、高性能应用的 IGBT 模块产品，技术规格将升级到 2000A/4500V，产品将主要应用于高压变频、智能电网和新能源汽车等领域。同时，该封测线将兼容 MOSFET、SiC 等半导体功率器件的生产，进一步丰富产品结构、拓宽收入来源，加强各业务板块间的协同效应，积极应对经济和市场的波动风险。

项目完成后，预计将形成月产 4 万只 IGBT 模块（兼容 FRD、SBD 等半导体功率模块）的封装测试能力。该封测线将同时兼容 MOSFET 等功率器件及 SiC 等宽禁带半导体功率器件的封测研发和批量作业，预计将形成月产 1.5 万只 SiC 等宽禁带半导体功率器件的封装测试能力。新建封测线将进一步提高公司在 IGBT 领域的技术实力，满足市场对高规格 IGBT 模块产品的需求，拓宽产品的应用领域，增强公司核心竞争力。

（2）月产 6,500 只高功率半导体脉冲功率开关（又称“固态脉冲开关”）生产线建设项目

高功率脉冲技术（High pulsed power technology）是指把缓慢储存起来的、具有较高密度的能量经过快速压缩、转换，最后有效地释放给负载的电物理技术。脉冲功率开关即开关单元，属于高功率、强电流的一种特殊设备，提供的是一种暂态过程的物理量，具备高脉冲功率、短脉冲持续时间、高电压、大电流的参数特征。

公司在脉冲功率开关领域与国内多家科研院所保持长期深入合作，已经积累了大量的技术经验和研究成果，具有全球领先的脉冲功率开关技术和产品，同时拥有多项原创发明专利。目前公司脉冲功率开关器件技术规格达到 300kA，脉冲功率开关组件技术规格达到 40kV，具有完全自主知识产权的超大半导体脉冲功率开关技术达到行业领先水平。

公司持续延展脉冲功率开关的产品应用领域，在国内多个重大前沿科技项目均得到应用，尤其在特种电源和新能源领域呈现迅速增长态势。此外，公司在强磁场、强激光等极端科研领域与国内顶尖的科研机构保持合作，在该细分领域中占据科研和工程应用的大部分市场份额。

本次募投项目中，公司将进一步推动脉冲功率开关产品线的产品升级，规格将进一步提升至 500kA/6,500V，预计将形成月产 6,500 只固态脉冲开关的生产能力。

（3）晶圆线改扩建项目，该生产线将同时兼容 6,500V 以上高压晶闸管芯片生产

公司采取设计、制造、封测一体的 IDM 模式，拥有完整的大功率半导体前道晶圆制造、中道芯片制程、后道器件封测产线，技术成熟，规模化生产且产销较为稳定。公司拥有多项核心知识产权，同时具备硅片高精度磨片机等相关专业设备，6 吋晶圆的出片率和良品率处于行业领先水平，对于电压规格在 5,000V 以下的 6 吋晶圆，良品率可以达到 90%。

本次募投项目中的晶圆线改扩建项目，作为与固态脉冲开关核心芯片完整配套的前道工序，将直接应用于高功率半导体脉冲功率开关的芯片生产。晶圆线改扩建项目所生产芯片将自产自用，维持公司在高功率脉冲功率器件的领先地位，确保公司在功率半导体的核心竞争力。

公司将积极推动晶圆制造工艺升级，目前已基本掌握 Bipolar 晶圆的工艺技术，晶圆线改扩建项目具备可行性。

（4）新型高功率半导体研发中心和营销中心建设项目

公司拟建设北京台基半导体新型高功率半导体研发中心，持续开展功率半导体新材料、新技术、新应用的标准化技术研究及先导技术研究，坚持自主研发和产学研结合，构建国家级科研平台和高级人才培养基地。新型高功率半导体研发中心专事于技术研发、产品设计和应用研究，包括 IGBT、MOSFET、PIM 等功率半导体器件、SiC、GaN 等宽禁带半导体材料和器件、固态（半导体）脉冲功率开关和新型功率半导体器件的设计及代工。研发中心的升级能使得公司将核心技术掌握在自己手中，保持在行业的领先地位，拉近与国际先进水平的距离。

公司拟建设北京台基半导体销售中心，进一步完善公司销售渠道布局，构建以华北地区（北京）为中心，长三角地区（上海）、珠三角地区（深圳）、华中地区（武汉）、西北地区（西安）及海外欧洲、日本、北美为主干支点，辐射到国内主要城市和海外市场热点地区的客户服务网络。营销中心将统筹新业务市场开发，建立全球市场服务和技术支持网络，并开展新型功率半导体器件贸易，主要为拓宽市场而建立。营销中心的升级将有助于公司更快占领市场，开展应用研究和服务，为新产品开发提供准备和积累，是公司产品服务的有益补充。

2、在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）公司拥有优质的研发团队与人才储备

公司拥有省级技术中心和大功率半导体技术湖北省重点实验室，在功率半导体领域拥有优质的研发团队与人才储备。公司建立了以颜家圣为代表的管理研发团队，在半导体技术、电力电子技术和脉冲功率技术领域拥有较为丰富的产业经验，具有行业领先水平的产品开发能力，近年来主持和参与起草国家或行业标准 17 项。截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 60 人，研发人员数量占比 10.91%。

公司高度重视人才发展，重视研发团队的建设。目前已经建立了包括职业培训、绩效考核、激励机制、企业文化建设在内的较为完善的人力资源管理制度，在长期生产实践中形成了一支掌握核心技术、先进生产工艺技术的专业技术队伍

以及具有开拓创新能力的经营管理人才队伍。

本次募投项目中，公司将根据公司战略及市场技术发展情况，制定负责人、项目预算和考核办法，每月在公司经营会上通报研发项目的进展情况。对已完成的研发项目进行评审接结案，对未完成的制定改进措施，促进项目完成。

（2）公司在功率半导体领域保持技术领先

公司通过持续 50 多年技术创新，积累了较为完整的具有自主知识产权的半导体产品设计和制造技术，掌握前道（晶圆制程）技术、中道（芯片制程）技术、后道（封装测试）技术。公司近年来承担了国家发改委、科技部、商务部等多项产品开发项目，并获得多项省级奖励。

公司建有 3 个省级科研平台、1 个国家级科研平台，拥有主要关键技术和产品的自主知识产权。截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 52 项专利技术（其中 7 项发明专利）和 30 余项专有技术。公司的晶闸管、高功率固态脉冲开关，采用自主研发模式，有自主单独的设计、工艺团队，在自有产线完成流片、封测和可靠性测试等工作，技术水平居于行业前列。

近年来，公司进一步深化产学研合作和科研平台建设，在技术导入、产品研发、试验检测、应用研究等方面积极开展合作，提升研发水平和效率，加快科研成果转化，为公司可持续发展提供技术支撑。

（3）公司拥有丰富的业务经验和销售渠道

公司主要产品为晶闸管、半导体模块等功率半导体器件及组件，在大功率半导体器件细分领域的综合实力、器件产能和销售规模位居国内同业前列。

公司根据客户的属性和服务需求，建立了大客户服务、一般客户直营服务和经销商服务的多层次服务体系，并在客户集中的地区，配备专业市场应用工程师和设备。公司重视与客户的技术交流和技术服务，为客户提供有针对性的解决方案和产品，满足客户的产品需求。

截至目前，公司在国内外具有 48 家一级特约经销商并同时经营电子商务平台，累计拥有海内外客户 3,000 余家，具有较高的品牌美誉度和知名度。

四、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施

（一）加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益

公司本次募投项目主要用于 IGBT 模块封测线建设、高功率半导体脉冲功率开关生产线建设、晶圆线改扩建、新型高功率半导体研发中心和营销中心建设，属于国家政策重点鼓励的产业，符合公司产业升级的需要，具有良好的市场前景和经济效益，有助于公司进一步提升行业地位，扩大市场份额。随着项目逐步进入运营期，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为确保募投项目按计划实施并尽快实现预期效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作。

（二）加强募集资金管理，保障募集资金按计划使用

本次募集资金到位后，公司将加强募集资金监管。本次发行的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关制度的要求规范管理募集资金，确保资金安全使用。同时，公司将进一步加快募集资金投资项目的建设进度，促使募投项目尽快产生预期效益。随着募集资金投资项目的顺利实施，公司将加快发展战略的实施步伐，进一步提升盈利能力。

（三）提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本

公司将持续改进完善业务流程，加强对采购、生产、销售、研发各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。

（四）落实利润分配政策，优化投资回报机制

公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》中的利润分配政策，在主营业务实现健康发展和经营业绩持

续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行A股股票对公司主要财务指标的影响及本次非公开发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析并提出了公司拟采取的填补措施，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员作出了关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺。具体如下：

（一）公司全体董事、高级管理人员的承诺

针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司的资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人将依法承担相应补偿责任。”

（二）公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司、实际控制人邢雁对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：

“针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”

六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报事宜的分析、填补即期回报措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告！

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月四日